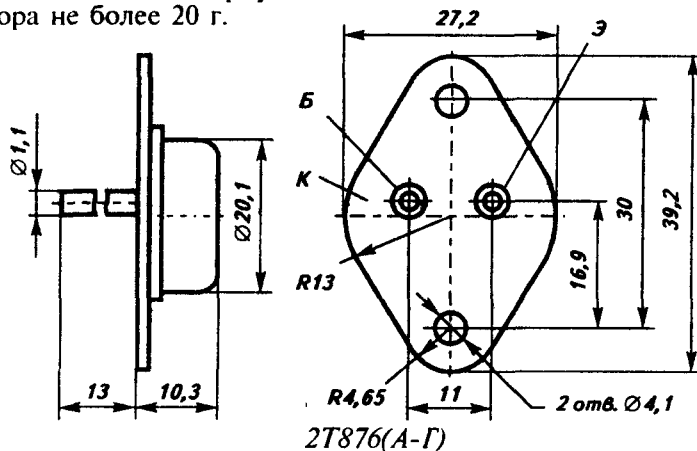


□ 2Т876А, 2Т876Б, 2Т876В, 2Т876Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* переключаемые. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 20 г.



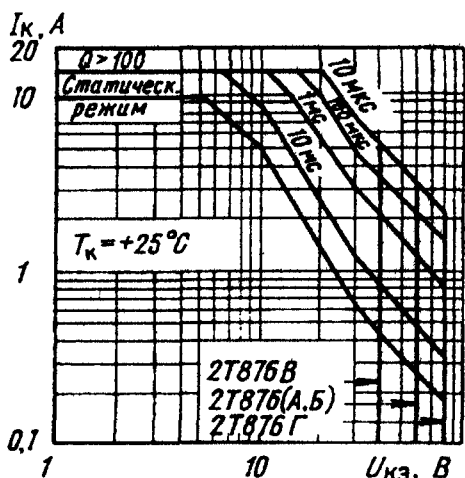
Электрические параметры

| | |
|---|---------------|
| Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_э = 5 \text{ А}$: | |
| 2Т876А, 2Т876Б, 2Т876В | 80...250 |
| 2Т876Г | 40...160 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10 \text{ В}$, $I_к = 0,5 \text{ А}$ | 20...120* МГц |
| Граничное напряжение при $I_к = 30 \text{ мА}$, не менее: | |
| 2Т876А, 2Т876Б | 60 В |
| 2Т876В | 40 В |
| 2Т876Г | 80 В |
| Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при $I_к = 5 \text{ А}$, $I_б = 1 \text{ А}$, не более | 0,5 В |
| Напряжение насыщения база - эмиттер при $I_к = 5 \text{ А}$, $I_б = 1 \text{ А}$, не более | 1,5 В |
| Время включения при $U_{кэ} = 30 \text{ В}$, $I_к = 5 \text{ А}$, $I_б = 0,5 \text{ А}$, не более | 0,25 мкс |
| типовое значение | 0,12 мкс |
| Время выключения при $U_{кэ} = 30 \text{ В}$, $I_к = 5 \text{ А}$, $I_б = 0,5 \text{ А}$, не более | 1 мкс |
| типовое значение | 0,4* мкс |
| Время спада при $U_{кэ} = 30 \text{ В}$, $I_к = 5 \text{ А}$, $I_б = 0,5 \text{ А}$, не более | 0,2 мкс |
| типовое значение | 0,05* мкс |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 \text{ В}$, типовое значение | 910* пФ |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5 \text{ В}$, типовое значение | 5500* пФ |
| Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$ не более | 3 мА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 \text{ В}$, не более | 10 мА |

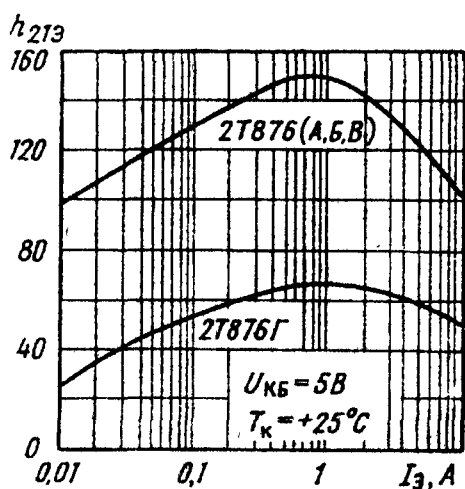
Предельные эксплуатационные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Постоянное напряжение коллектор - база: | |
| 2Т876А, 2Т876Г | 90 В |
| 2Т876Б | 70 В |
| 2Т876В | 50 В |
| Постоянное напряжение коллектор - эмиттер: | |
| при $R_{бэ} = 100 \text{ Ом}$: | |
| 2Т876А, 2Т876Г | 90 В |
| 2Т876Б | 70 В |
| 2Т876В | 50 В |
| при $R_{бэ} = \infty$: | |
| 2Т876А, 2Т876Б | 60 В |
| 2Т876В | 40 В |
| 2Т876Г | 80 В |
| Постоянное напряжение база - эмиттер | 5 В |
| Постоянный ток коллектора | 10 А |
| Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 \text{ мс}$ | 15 А |
| Постоянный ток базы | 3 А |
| Импульсный ток базы при $t_{и} = 10 \text{ мс}$ | 5 А |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_к = -60...+25^\circ\text{C}$: | |
| с теплоотводом | 50 Вт |
| без теплоотвода | 3 Вт |
| Температура <i>p-n</i> перехода | +150°C |
| Температура окружающей среды | -60°C... $T_к = +125^\circ\text{C}$ |

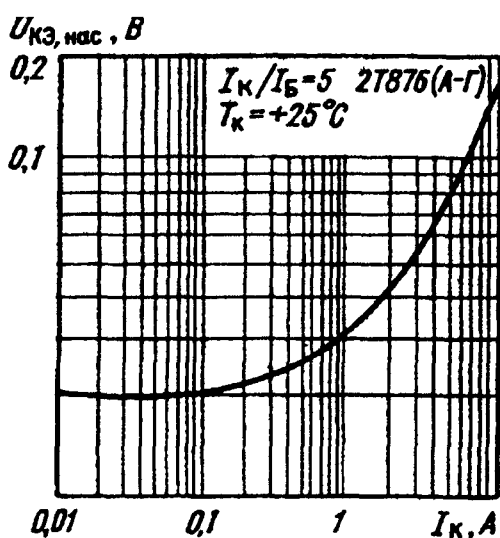
¹ При $T_к > +25^\circ\text{C}$ $P_{к, макс}$ снижается линейно на 0,4 Вт/°C с теплоотводом и на 24 мВт/°C без теплоотвода.



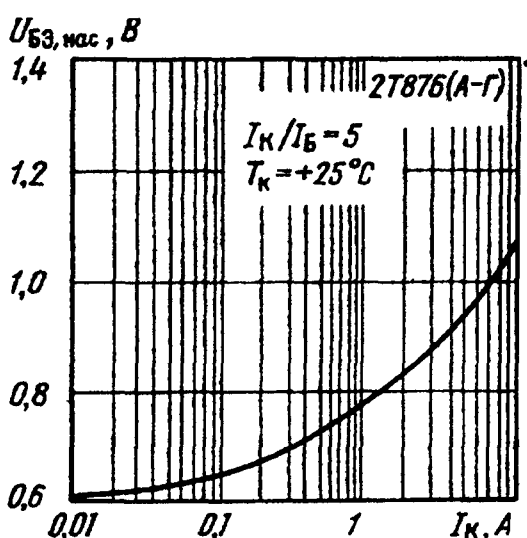
Области безопасной работы транзисторов



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор - эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база - эмиттер от тока коллектора